

## パワー半導体用 SiC エピウェハー 高品質グレード品の 3 次増強を決定 -市場の急成長に伴い安定供給体制を整備-

昭和電工株式会社（社長：森川 宏平）は、パワー半導体の材料である炭化ケイ素（以下、SiC）エピタキシャルウェハー（以下、エピウェハー）の高品質グレードエピウェハー「ハイグレードエピ（以下、HGE）」について、追加増強を決定しました。当社の月産能力は本年9月に現在の5000枚から7000枚に拡大しますが、今回の追加増強により、2019年2月には9000枚まで到達する予定です<sup>（注1）</sup>。

SiC パワー半導体は、現在主流の Si（シリコン）製に比べ耐高温・耐電圧・大電流特性に優れた半導体で、電力制御に用いるモジュールの軽量・小型化と省エネルギー化に貢献することから、次世代パワー半導体として注目されています。新エネルギーの分散型電源やデータセンターのサーバー用電源、鉄道車両のインバータモジュールに加え、急速に伸長する電気自動車市場においても、車載充電器や急速充電スタンドで SiC パワー半導体への切り替えが進んでいます。

当社の SiC エピウェハー事業は、業界最高水準である HGE の欠陥密度の低さと高い均一性において高い評価を得られています。当社は 2017 年 9 月と 2018 年 1 月の 2 回生産能力の引き上げを決定しました<sup>（注2）</sup> が、SiC パワー半導体市場の急成長に伴うお客様からの旺盛な需要にお応えすべく、今回さらなる投資を決定しました。

当社は引き続き SiC エピウェハーにおけるトップレベルのシェアと品質の維持向上に取り組み、需要の高まる SiC パワー半導体市場へタイムリーで安定的な製品供給に努めてまいります。

以上

（注1）1200V 耐圧用デバイス仕様での換算

（注2）2018年1月23日発表「パワー半導体用 SiC エピウェハー高品質グレード品追加増強を決定」

